0.1	共源极放大电路		2
	0.1.1	知识点回顾: MOS 小信号模型	2
	0.1.2	漏极电阻负载的共源极	2
	0.1.3	Diode-connected MOS Load 二极管连接的 MOS 负载	4
	0.1.4	Current Source Load	6
	0.1.5	线性区 MOS 负载	7
	0.1.6	Source degeneration: 源极负反馈	7

0.1 共源极放大电路

0.1.1 知识点回顾: MOS 小信号模型

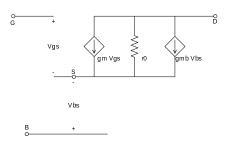


图 1: 小信号模型

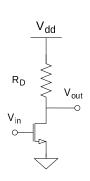


图 2: 大信号模型

$I_{ds} = K_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \qquad (1)$

$$g_{m} = 2K'_{n} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$$

$$= 2\sqrt{K'_{N} \frac{W}{L} I_{ds}}$$

$$= \frac{2I_{ds}}{V_{GS} - V_{TH}}$$
(2)

$$r_0 = \frac{V_M L}{T_{ds}} = \frac{1}{\lambda I_{ds}} \tag{3}$$

0.1.2 漏极电阻负载的共源极

0.1.2.1 Gain 增益

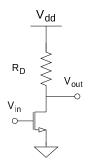


图 3: 共源极放大电路

$$A_v = -g_m R_D \tag{4}$$

0.1 共源极放大电路

 $(g_m 与 I_D 有关)$

3

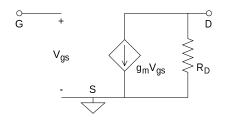
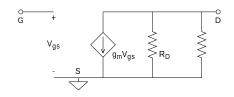


图 4: 不考虑沟道调制的小信号模型

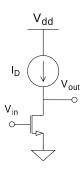


 $A_v = -g_m(R_D||r_0) \tag{5}$

图 5: 考虑沟道长度调制的小信号模型

若 MOS 管不变, 其能达到的最高增

益为: $R_D \to \infty$ 一般来说: $\frac{1}{g_m} << r_0$



 $intrisic\ gain:\ A_v=-g_mr_0$ (6)

图 6: 源负载的共源放大电路

0.1.2.2 Input Impedence 输入阻抗

悬空输出,测试输入阻抗:

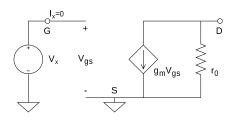


图 7: 测量输入阻抗

$$r_{in} = \infty \tag{7}$$

0.1.2.3 Output Impedence 输出阻抗

输入接地,测量输出电阻

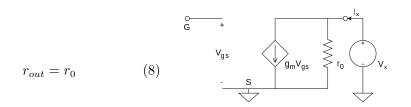


图 8: 测量输出电阻

0.1.3 Diode-connected MOS Load 二极管连接的 MOS 负载

• 求从 M2 的 S 极往上看的电阻:

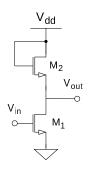


图 9: 二极管连接的 MOS 负载

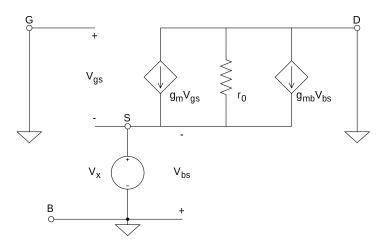


图 10: 求从 M2 的 S 极往上看的电阻

$$\frac{V_x}{r_0} = i_x - g_m V_x - g_{mb} V_x \tag{9}$$

$$(\frac{1}{r_0} + g_m + g_{mb})V_x = i_x \tag{10}$$

$$\frac{V_x}{i_x} = r_{in} = \frac{1}{\frac{1}{r_0} + g_m + g_{mb}} \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} \approx \frac{1}{g_m}$$
(11)

0.1.3.1 增益

$$A_{v} = -g_{m1}R_{Load}$$

$$= -g_{m1}(\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}||r_{0})$$

$$\approx -\frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}}$$

$$= -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}(\frac{1}{1+\eta})$$

$$\approx -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$
(12)

$$A_v = -\sqrt{\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_1}{\left(\frac{W}{L}\right)_2}} \times \frac{1}{1+\eta} \tag{13}$$

缺点: η 会随着 V_{in} 的变化而变化,造成增益 A_v 随着 V_{in} 而变化。

Solution: 将 M_2 换成 PMOS!

如图 11:

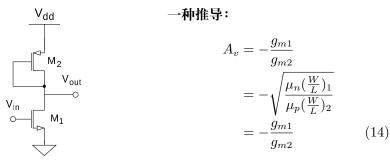


图 11: 二极管连接的 PMOS 作负载

这个电路的 Gain 不随着 V_{in} 的变化 而变化, Gain 是恒定的。

另一种推导:

$$\mu_n(\frac{W}{L})_1(V_{GS1} - V_{TH1})^2 = \mu_p(\frac{W}{L})_2(V_{GS2} - V_{TH2})^2$$

$$\frac{|V_{GS2} - V_{TH2}|}{(V_{GS1} - V_{TH1})} = -\sqrt{\frac{\mu_n(\frac{W}{L})_1}{\mu_p(\frac{W}{L})_2}} = A_v$$
(15)

我们发现了一种巧合:增益 = 过驱动电压之比

结论:要使增益很大,过驱动电压之比也要很大, M_2 与 M_1 的尺寸之比太大(电路无法实现)。

Solution: M_2 旁增加受控电流源

如图 12:

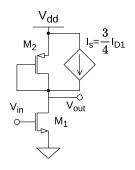


图 12: 增加旁路受控源

$$A_{v} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$= -\sqrt{\frac{2K'_{n}(\frac{W}{L})_{1}I_{D1}}{2K'_{p}(\frac{W}{L})_{2}I_{D2}}}$$

$$= -\sqrt{\frac{4K'_{n}(\frac{W}{L})_{1}T_{Dk}}{K'_{p}(\frac{W}{L})_{2}T_{D2}}}$$

$$= -2\sqrt{\frac{K'_{n}(\frac{W}{L})_{1}}{K'_{n}(\frac{W}{L})_{2}}}$$
(16)

如果考虑沟道长度调制效应: $A_v = -g_{m1}(\frac{1}{g_{m2}}||r_{o1}||r_{o2})$

0.1.4 Current Source Load

0.1.4.1 Gain 增益

图 13: 电流源负载的共源

提高增益的方法:

- 1. increase r_{o1} and r_{o2} : $\lambda \propto \frac{1}{L} \ r_o \propto \frac{L}{I_D} \ \text{增大 L 即可 (W 也要等比例增大)}$
- 2. increase g_{m1} : $g_{m1} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} V_{TH})$ $\frac{W}{L}$ 增大

 $\dot{\text{P}}$ 地大 $(V_{GS}-V_{TH})$ 没用: 因为 $I_D \propto (V_{GS}-V_{TH})^2 \rightarrow r_o \uparrow$

0.1.5 线性区 MOS 负载

0.1.5.1 Gain 增益

M₂ 工作在线性区:

$$A_{v} = -g_{m}R_{ON2} \tag{18}$$

$$R_{ON2} = \frac{1}{\mu_{p}C_{ox}(\frac{W}{L})_{2}(V_{DD} - V_{b} - |V_{THp}|)}$$

$$V_{b} \qquad M_{2}$$

$$V_{out} \qquad V_{out} \qquad V_{out} \qquad V_{in} \qquad M_{1}$$

图 14: 线性区 MOS 负载

0.1.6 Source degeneration: 源极负反馈

0.1.6.1 Gain 增益

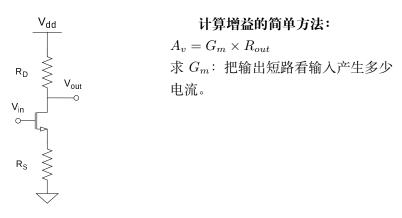


图 15: 带源极负反馈的共源电路

大信号法:

$$G_{m} = \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{in}}$$

$$= \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$$

$$= g_{m} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$$
(19)

$$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_S$$
(20)

将 20 带入 19 中:

$$G_m = g_m(1 - G_m R_S) \Rightarrow G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S}$$
 (21)

所以:

$$A_v = -G_m R_S = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} R_D \tag{22}$$

小信号法:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

接注: ignore
$$\lambda$$
 and γ :
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$V_{out} = -g_m (V_{in} - V_S) R_D \qquad (23)$$

$$V_S = g_m (V_{in} - V_S) R_S \qquad (24)$$

图 16: 小信号法

由 24 可得:

$$V_S = \frac{g_m R_S V_{in}}{1 + g_m R_S} \tag{25}$$

将 25 带入 23 有:

$$V_{out} = -g_m V_{in} (1 - \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}) R_D$$
 (26)

所以:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} R_D = \frac{-R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S} = -G_m R_D$$
 (27)

所以:

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \xrightarrow{\underline{rearrange}} \frac{1}{R_S + \frac{1}{a}}$$
 (28)

结论: G_m 比 g_m 变小了 $1+g_mR_S$ 倍。

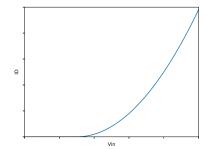
对比: 若 $R_S = 0$ (不带 degeneration 的情况):

$$G_m = \frac{1}{0 + \frac{1}{g_m}} = g_m \tag{29}$$

随着 R_S 的增大 $\to g_m$ 在 G_m 中的占比减小 $\to V_{in}$ 对 G_m 的影响减小 \to 增益更加线性!

有和没有 source degeneration 的 I_D 和 g_m 对比

如图 17 与图 18 所示:



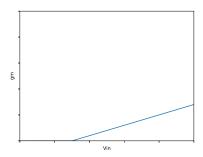


图 17: 不带 source regeneration 的图像

10 月录

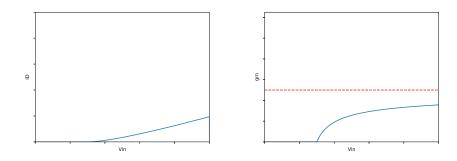


图 18: 带 source regeneration 的图像

可以注意到,带有 source degeneration 的电路增益基本不变,趋近于 $\frac{1}{R_S}\circ$

0.1.6.2 不忽略 λ 和 γ 的跨导 G_m

如图 19 所示画出小信号图 $(V_b=0)$

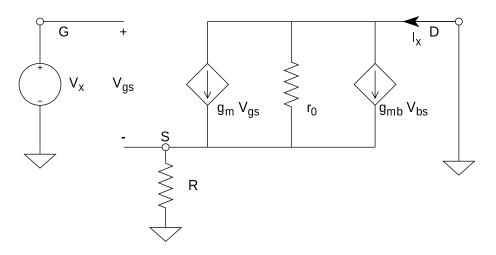


图 19: 计算跨导 G_m

$$V_{S}(\frac{1}{R} + r_{0}) = g_{m}(V_{x} - V_{S}) - g_{mb}V_{S}$$

$$V_{S} = \frac{g_{m}}{g_{m} + g_{mb} + \frac{1}{r_{0}} + \frac{1}{R_{S}}}V_{x}$$

$$I_{x} = \frac{V_{S}}{R}$$

$$= \frac{g_{m}}{R_{S}(g_{m} + g_{mb} + \frac{1}{r_{0}}) + 1}V_{x}$$

$$G_{m} = \frac{I_{x}}{V_{x}}$$

$$= \frac{g_{m}}{R_{S}(g_{m} + g_{mb} + \frac{1}{r_{0}}) + 1}$$
(30)

0.1.6.3 Output Impedence 输出阻抗

用一样的小信号法,可以计算出:

$$r_{out} = [1 + (g_m + g_{mb})r_0]R + r_0$$
$$= [(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_0})R + 1]r_0$$
(31)

结论:比没有 R_S 的时候增大了很多。

0.1.6.4 增益 Gain again

$$A_V = -G_m(R_D \mid\mid r_{out}) \tag{32}$$

结论,比没有 R_S 的时候变小了许多。增益下降了

观察: 当 $R_D = \infty$ 的时候:

$$A_V = -g_m r_0 \tag{33}$$

就是本征增益